

5 СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

5.7 Силовой модуль МТКП1-100-1-1, МТКП1-100-1-2

• ВЛЕИ.435714.001ТУ

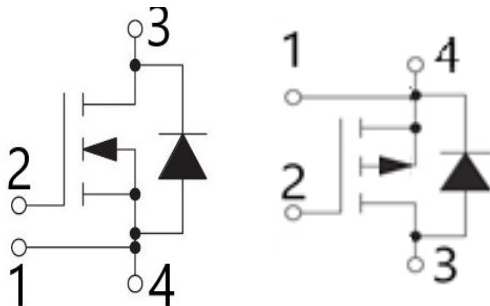
Силовой транзисторный модуль с изолированным основанием. В составе модуля n- канальный полевой транзистор (МТКП1-100-1-1) или р- канальный полевой транзистор (МТКП1-100-1-2) с дополнительным истоковым выводом для подключения схемы управления. В конструкции модуля отсутствует медное базовое основание, что повышает его надежность и его эксплуатационные характеристики

Особенности:

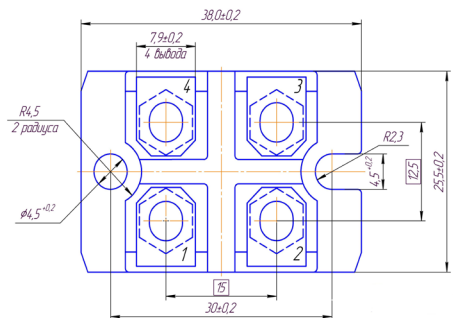
- Изолированный корпус
- Низкое сопротивление открытого канала
- Монтаж и подключение без пайки



Внешний вид модуля в корпусе КТ-135А-1НК



1	Исток
2	Затвор
3	Сток
4	Исток



Параметр	Буквенное обозначение	Режим работы	Значение n- канал	Значение p- канал
Напряжение сток исток, В	$U_{СИ}$	$T_{кр} = 25^{\circ}C$	100	-100
Постоянный прямой ток через транзистор, А	$I_{ПР}$	$T_{кр} = 25^{\circ}C$	100	-100
Начальный ток стока транзистора, мкА	$I_{С-нач}$	$T_{кр} = 25^{\circ}C$, $U_{СИ} = 100 В$ $U_{ЗИ} = 0 В$	100	-100
Сопротивления открытого канала транзистора, Ом	$R_{СИ-отк}$	$T_{кр} = 25^{\circ}C$, $I_{С} = 100 А$, $U_{ЗИ} = 10 В$, $I_{имп} = 100 мкС$	0,010	0,020
Пороговое напряжение транзистора, В	$U_{ЗИ}$	$T_{кр} = 25^{\circ}C$, $I_{С} = 250 мкА$, $U_{ЗИ} = U_{СИ}$	2÷-5	-1,5÷-5
Тепловое сопротивление переход корпус, °С/Вт	R_t		0,5	0,5